



## **2SD1073: Transistor Darlington High Power NPN 50V 4A**



# Descripción

**Nombre:** TRANSISTOR DARLINGTON HIGH POWER **Referencia:** 2SD1073

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 4A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 250V
- Tensión VCBO colector-base: 300V
- Voltaje VEBO emisor-base: 30V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 1.5V (IC=1A;IB=10mA )
- Dp - Disipación de potencia: 60 mW
- Temperatura de trabajo: desde - 55°C hasta + 150°C

**Marca:** FUJI[FUJI ELECTRIC] **Empaque:** TO-220 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [2SD1073](#)

## Información del producto

**Descripción:** TRANSISTOR DARLINGTON HIGH POWER. Marca: FUJI[FUJI ELECTRIC]. Referencia: 2SD1073 El 2SD1073 es un transistor Darlington NPN de alta potencia, ideal para aplicaciones que requieren una alta ganancia de corriente y la capacidad de manejar cargas significativas. Su versatilidad y robustez lo convierten en un componente muy utilizado en electrónica de potencia.

**Precio:** \$9.332 IVA INCLUIDO

**SKU:** 9-5-136

**Categorías:** [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

**Etiquetas:** [0090005000136](#), [2SD1073](#), [9-5-136](#), [datasheet](#), [FUJI\[FUJI ELECTRIC\]](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR DARLINGTON HIGH POWER](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Exchange Information		Product Specification		
Silicon NPN Power Transistors		2SD1073		
<b>DESCRIPTION</b>				
• High V <sub>CE</sub> operation				
• High DC current gain				
• DARLINGTON				
• Low saturation voltage				
<b>APPLICATIONS</b>				
• Audio power amplifiers				
• Relay and solenoid drivers				
• Motor drives				
• General purpose power amplifiers				
<b>PACKAGE</b>				
Case	TO-220			
1	Base			
2	Collector			
3	Emitter			
<b>Absolute maximum ratings (Ta=25°C)</b>				
Symbol	Parameter	Conditions	Value	Unit
V <sub>CE</sub>	Collector-emitter voltage	Open emitter	250	V
V <sub>CB</sub>	Collector-base voltage	Open emitter	300	V
V <sub>EB</sub>	Emitter-base voltage	Open collector	30	V
I <sub>C</sub>	Collector current	Open emitter	4	A
I <sub>E</sub>	Emitter current	Open collector	4	A
P <sub>D</sub>	Collector power dissipation	T <sub>C</sub> =25°C	60	mW
T <sub>C</sub>	Collector junction temperature		150	°C
T <sub>stg</sub>	Storage temperature		-55 to 150	°C
<b>THERMAL CHARACTERISTICS</b>				
Symbol	Characteristic	Value	Unit	
R <sub>θ(j-c)</sub>	Collector-emitter thermal resistance	0.6	°C/W	